组合式钕玻璃片状激光放大器 增益性能的动态模拟*

张 华

(南通师范学院物理系,南通 226007)

范滇元

(中国科学院上海光学精密机械研究所,上海 201800)(2001年2月8日收到,2001年4月2日收到修改稿)

用随时间变化的氙灯辐射光谱模型,建立了组合式钕玻璃片状激光放大器动态增益特性的模拟程序,实现了 从氙灯放电到引出激光的全过程动态模拟,可用于片状激光放大器的优化设计.研究了:1)放大器在不同的抽运条 件下水平方向的增益均匀性,当氙灯爆炸系数比较高时,自发辐射放大优先使片的边缘产生消抽运作用,增益分布 变得不均匀,通光口径的中央处增益较大 2)片厚度和掺杂浓度对增益性能的影响,在相同的抽运条件下,储能通 量由片厚度与掺杂浓度的乘积决定,给出了储能通量和小信号增益随片厚度与掺杂浓度的乘积的变化关系.

关键词: 钕玻璃激光放大器, 储能密度, 增益特性 PACC: 4260, 3280B, 3380B, 2588

1 引 言

惯性约束核聚变的研究对能源发展具有重要意 义,其研究的关键在于建造具有高功率、高光束质量 的激光系统. 氙灯抽运的组合式钕玻璃激光放大器 是国际上进行惯性约束核聚变研究的主要激光驱动 器. 它的技术基础是抽运源及其在激光介质中的能 量沉积, 它决定了增益、增益均匀性、效率及动态光 学质量等关系全局的重要参量. 为了获得大能量、高 光束质量的激光输出,要求放大器具有优质的增益 性能.

由于激光驱动器结构复杂、规模巨大,因此,用 计算机程序模拟激光驱动器的性能具有非常重要的 意义.美国里弗莫尔国家实验室等世界上一些著名 实验室在多年的激光驱动器研究过程中不断深化对 放大器增益性能的研究^[1],发展了一系列模拟放大 器增益性能的程序.Alexander等^[2]首次用蒙特-卡罗 和光线追迹方法完成了抽运光在放大器腔内传输的 模拟计算程序 ZAP,ZAP可以计算抽运光在激光介 质内的能量沉积分布和传输效率.Hagen等^[3]在单 元激光放大器(SSA)上详细地研究了抽运腔的构形 对储能效率的影响,建立了一系列模拟SSA能量沉 积分布、边缘损耗和增益均匀性的计算程序.Murray 和 Erlandson 等^[45]提出和发展了组合式放大器 (MSA),发展了模拟MSA内增益性能的程序.这个 程序采用简化的二维光线追迹模型,用一个无限薄 的吸收平面代替有限厚度的钕玻璃片,对片上的每 一个源点进行积分,平面上的每一点吸收了同样的 入射到钕玻璃片的抽运光通量.1994年里弗莫尔实 验室又建立了 Beamlet 激光装置^[6,7].Erlandson等^[7] 研究了 Beamlet 装置的增益特性,用在MSA-2 上发 展起来的外推方法来预估其增益特性.

本文发展了模拟氙灯抽运的组合式钕玻璃片状 激光放大器动态增益特性的计算机程序,并利用国 内外的实验和计算结果对程序的精度和可靠性进行 校验和考核.与已有工作相比,主要的改进有:

1 》物理模型精确化.运用随时间变化的氙灯辐 射光谱模型,建立了放大器从电容器放电到引出激 光的全过程增益特性动态模拟,可计算抽运过程中 不同时刻放大器内的储能分布.

2) 采用二维光线追迹方法, 既可以模拟放大器

^{*}国家高技术研究发展计划青年科学基金(批准号 :416 – 98 – 08)和江苏省教育委员会自然科学基金(批准号 99KJB140007)资助的课题.

[†]E-mail :zh@nttc.edu.cn

在水平和片厚度方向的储能分布,又具有比较快的 计算速度,能在20min 左右的时间内完成一次计算. 而一般的三维光线追迹程序如ZAP²¹,完成一次储 能分布计算需要几小时乃至整天的时间^{[51}.文献5] 模拟 MSA 内增益性能的二维光线追迹程序,由于用 一个无限薄的吸收平面代替有限厚度的钕玻璃片, 因此不能模拟在片厚度方向的储能分布.

3)由于端面损耗,内部片和端面片上的增益分 布是不一样的.程序可以计算放大器内部和端面任 一位置钕玻璃片上的储能分布,由此外推任意长放 大器链的水平方向的增益分布.

4)用蒙特-卡罗方法处理自发辐射放大(ASE), 可同时计算包边吸收 ASE 能量的分布,作为热畸变 效应研究的依据.这些程序和方法还可以运用到大 口径的固体板条激光器⁸¹.

2 原理概述

2.1 二维光线追迹法

组合式放大器在竖直方向具有比较好的增益均 匀性^[5-7] 因此在空间上将三维模型简化为二维模 型.而且,实际上由于在放大器的底部和顶部安装了 反射镜,把有限长度的氙灯、钕玻璃片"反映"成无限 长,所以,只要二端面的反射率足够高,二维近似就 是一种很好的计算方法^{59,10]}.图1是组合式片状放 大器的结构示意图,每张钕玻璃片由侧面和中央两 组氙灯进行抽运.钕玻璃对抽运光的吸收遵从比尔 定律^[11]

 $I(\lambda, d, t) = I_0(\lambda \rho, t) \exp[-\alpha(\lambda)d].$ (1) 钕玻璃对不同光谱成分的光线吸收的能量是不同 的 (1)式中 $I_0(\lambda \rho, t)$ 为抽运光在波长 λ 处的初始 强度(kW/µm),在数值上等于所有氙灯在波长 λ 处 辐射的功率除以所有取样光线数目,对时间和波长 的依赖关系由随时间变化的氙灯辐射光谱确定^[12]; $\alpha(\lambda)$ 为根据实验数据拟合出来的磷酸盐钕玻璃的 吸收系数,与掺杂浓度成正比.实验测量了掺杂浓度 为 2.2% 国产钕玻璃的吸收光谱,并对此作了经验 函数的拟合,从而可以得到任意掺杂浓度下钕玻璃 的吸收系数^[10]; d 为光线在钕玻璃片中传输的 距离.

为了计算钕玻璃片内储能分布,用两组分别平 行于片两个侧面的平行线将片截面分割成许多小的



图 1 组合式片状激光放大器的结构示意图

矩形区域,计算光线在每个小区域内沉积的能量.某 个小区域内沉积的能量是所有取样光线在该区域内 沉积能量的总和,该小区域内的抽运功率密度为

$$P(x,y,t) = \frac{1}{\Delta V} \sum_{n=1}^{N} \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \frac{\lambda}{\lambda_0} [1 - \exp(-\alpha(\lambda)d_n)]$$
$$\cdot [(\lambda,x,y,t)] \lambda \qquad (2)$$

式中 $\sum_{n=1}^{N}$ 表示对所有 *N* 根取样光线在该体积元内沉 积能量求和 ; λ_0 为钕离子的激光跃迁波长 ; d_n 为第 *n* 根光线在该体积元内传输的距离 ; $I_n(\lambda_{,x},y_{,t})$ 为 第 *n* 根光线进入该体积元时在波长 λ 处的强度 (kW/ μ m).

2.2 氙灯的辐射光谱

在氙灯对钕玻璃片的抽运过程中,放电电流随时间变化,因此,氙灯的辐射光谱也是随时间变化的,在方程(1)中 $I_0(\lambda,0,t)$ 是随时间变化的.运用精确的氙灯辐射光谱模型^[12],可得到随时间变化的 氙灯辐射光谱.根据 Gonez 公式,氙灯的单发爆炸能量为 $E_x = BSd(LC)^{1/4}$,在一般的设计中B = 20,把输入氙灯的能量与氙灯单发爆炸能量的比值定义为氙灯的爆炸系数,

$$f_x = \frac{CV^2}{2BSd(LC)^{1/4}},$$
 (3)

S 为氙灯长,d 为氙灯内径.图2是内径为2.5cm的 氙灯在f_x=0.3时的放电波形和辐射光谱.在放电 过程中氙灯的辐射光谱有很大差异,随着电流增大, 波长较小的区域强度增加较快,也就是通常所说的 紫移现象.



图 2 氙灯的放电波形和辐射光谱 (a)为放电波形 (b)为氙灯放电过程中几个时刻的辐射光谱

2.3 抽运速率方程

由激光速率方程可得到描述激光介质内随时间 和空间变化的激光上能级储能密度 *E*_s(*x*,*y*,*t*)的 抽运速率方程为

$$\frac{\mathrm{d}E_{\mathrm{st}}(x,y,t)}{\mathrm{d}t} = P(x,y,t) - \frac{E_{\mathrm{st}}(x,y,t)}{\tau}, (4)$$

式中 P(x, y, t)是由(2)式确定的抽运功率密度,它 是时间和空间位置的函数; $\tau = 1(k_0 + k_{ASE}), 1/k_0$ 为钕玻璃的荧光寿命, k_{ASE} 为由于 ASE 所引起的激 光上能级寿命的减少,在大口径、高增益的片状激光 放大器中尤其突出^[13-15].

方程(4)可用有限差分法求解,取时间间隔 Δt , 在 $t = (p+1)\Delta t$, p = 0, 1, 2, ...时体积元 ΔV 内的储 能密度 $E_{s}(x, y, p+1)$ 可表示为

$$E_{st}(x,y,p+1) = [E_{st}(x,y,p) + p(x,y,t)\Delta t] \\ \times \exp(-\Delta t/\tau).$$
(5)

2.4 自发辐射放大

在 △t 时间内自发辐射能量密度为

 $E_{sp}(x, y, p) = [1 - exp(-\Delta t/\tau)]E_{st}(x, y, p).$ (6)

用蒙特-卡罗方法处理片状放大器内的 ASE^[13],而 不是用文献 14]中拟合 k_{ASE} 的方法,这样可以研究 ASE 对片边缘区域的储能衰减及包边吸收 ASE 能 量的分布.假设自发辐射是各向同性的,体积元 ΔV 内辐射相互独立的 M 根光线,每根光线的始点位置 和方向由蒙特-卡罗方法随机产生,每根光线携带的 能量为 $I_{\rm sp}(x, y, p) = E_{\rm sp}(x, y, p) \Delta V/M.$ (7)

荧光光线在增益介质中传输时被放大,同时消耗激 光介质中的储能,用同样的光线追迹方法计算 ASE 消耗的储能,某体积元内的储能密度衰减为

$$E_{ASE}(x, y, p) = \frac{1}{\Delta V} \sum_{n=1}^{N} f_{ASE}^{(n)}(x, y, p)$$

× [exp($\beta(x, y, p)t_n$) - 1] (8)

 $\sum_{n=1}^{N}$ 表示对所有 N 根取样荧光光线求和 , $f_{ASE}^{n}(x,y)$, p)为第 n 根荧光光线进入该体积元时的强度 , t_n 为 第 n 根光线在该体积元内传输的距离 ,f(x,y), p)为 随时间和空间位置变化的小信号增益系数 ,

 $\beta(x, y, p) = E_{s}(x, y, p)\sigma/h\nu.$ (9)

3 水平方向增益均匀性的动态模拟

3.1 水平方向增益分布与氙灯爆炸系数的关系

以 Beamlet^[7,8]放大器的结构参量作为计算参量.图 3 给出了在 5 种不同的氙灯爆炸系数 f_x 时一张内部片的水平增益分布计算结果,对应的抽运时刻为 0.34 ms.增益分布在低 f_x 值时相对平些,而当 f_x 值升高时变得不均匀,通光口径的中央处增益较大.产生这种现象的原因可以归结为两个方面,第一是由于 ASE,它优先使玻璃片的边缘产生消抽运作用 增加了片边缘储能的衰减速率.而且,随着片平均增益系数的增大,消抽运的作用更加严重;第二是抽运能量沉积分布随注入氙灯能量的改变而变化. 文献 5 的实验结果表明由类似氙灯列阵所产生的 增益分布很难随驱动氙灯能量的改变而变化,因此, ASE的影响更为主要.



3.2 水平方向增益分布随时间的变化

0.18ms

0.34ms

0.4

放电时间 t/ms

0. 42 ms

0.6

0.8

 $12\,\mathrm{ms}$

0. 06 ms

0.2

12

10

8

6

2

0.0

电流强度 I/kA

在抽运过程中的不同时刻水平方向的增益分布 特性也具有很大的差异.图 4(a)给出了 Beamlet 放 大器氙灯在主脉冲启动后的电流波形的计算结果, 氙灯爆炸系数为 0.3.图 4(b)给出了计算得到的放 大器5个不同时刻的水平增益分布.0.06.0.12和 0.18ms 对应于抽运脉冲前沿的三个时刻 增益分布 沿水平方向比较均匀,在0.34ms时储能密度取得最 大值 0.42ms 是抽运脉冲后沿的一个时刻,这时增 益分布沿水平方向不均匀,值得注意的是,在抽运脉 冲的后沿出现明显的峰值效应。即由于 ASE 的影 响 在通光口径的中央处增益比较大 水平增益分布 不均匀,而在抽运脉冲的前沿,即使与后沿的平均增 益系数相近,这种峰值效应也不明显,这主要因为 ASE 加快片边缘储能衰减对时间的积累效应, 图 4(b)中的点是文献 7 的实验结果,与程序的计算结 果符合得很好,证实了程序的精度和可靠性,



图 4 水平方向增益分布随时间的变化 (a)为氙灯的放电波形 (b)为水平方向的增益分布

(a)

4.1 单张钕玻璃片的引出激光增益

 $E_{\text{out}} = E_{\text{sat}} \ln \left[1 + \exp \left(\beta \left(y \right) \Delta y' \right) \right]$

×(exp(E_{in}/E_{sat}) – 1)]exp(– $\alpha \Delta y'$), (10) 式中 E_{in} 和 E_{out} 分别为激光脉冲的输入和输出通量, $\beta(y)$ 是由(9)式决定的随位置变化的小信号增益系 数 光线在呈布儒斯特角放置的钕玻璃片中传输的 距离为 $\Delta y' = \Delta y(1 + n^{-2})^{1/2}$, $E_{sat} = hv/\rho\sigma$ 为钕玻璃 的饱和通量 ρ 为一系数 对于国产磷酸盐钕玻璃 ρ = 1.15.将所有"薄片"的增益相乘得到激光脉冲通 过单片钕玻璃片的增益.

4.2 储能密度沿片厚度方向的分布

组合式放大器中每张钕玻璃片用侧面和中央两

组氙灯列阵抽运.图 5(a)为在相同的抽运强度下, 储能密度沿钕玻璃片厚度方向的相对分布,片的厚 度为 4cm,不同的曲线分别对应于不同的掺杂浓度. 可见,储能密度沿厚度方向的分布是十分不均匀的, 随着吸收深度的增加,储能密度很快地衰减.钕离子 浓度越高衰减速度越快,片中心的储能密度也越低. 图 f(b)为厚度为 3.5cm 的钕玻璃片的计算结果,与 图 f(a)相比,在片的表面两片的储能密度相同,但 在片的中心"薄片"的储能密度要高于"厚片".



图 5 钕玻璃片内部储能密度沿片厚度方向的相对分布 (a)为 D = 4cm (b)为 D = 3.5cm

4.3 钕玻璃片的储能通量和增益

图 (*a*)为钕玻璃片的储能通量对片厚度与钕 离子浓度乘积的关系曲线.储能通量定义为放大器 口径上单位面积内的储能^[14].厚度为 3.5 和 4.0cm 两片的两条曲线完全重合在一起,而与厚度无关,即 在相同的抽运条件下,储能通量完全取决于片厚度 与钕离子浓度的乘积 *N*₀*D*.而且,当 *N*₀*D* 比较小 时,储能通量随 *N*₀*D* 的增加很快地增加;当 *N*₀*D* 比 较大时,储能通量趋于饱和,因为钕玻璃片几乎已经 吸收了吸收带内的全部抽运光.图 6(b)为由(10)式 计算得到的单片增益,增益随片厚度和钕离子浓度 的增大而增大.对各种片厚度和钕离子浓度的计算 结果均表明:在 N₀D 相等时可以得到相同的增益. 当 N₀D 比较小时,N₀d 增加1倍时储能通量增加 1.25 倍,相应的单张钕玻璃片增益提高5.5%,对于 7 片长的放大器链,总的小信号增益将提高45%.



图 6 (a)为储能通量随片厚度和钕离子浓度乘积 N₀D 的变化关系 (b)为单张钕玻璃片的增益

5 结 论

建立了组合式钕玻璃片状激光放大器动态增益 特性的模拟程序,实现了从氙灯放电到引出激光的 全过程动态模拟.研究了放大器在水平方向的增益 均匀性和片厚度与掺杂浓度对增益性能的影响.结 果表明:1)当氙灯爆炸系数比较高时,自发辐射放大 优先使片的边缘产生消抽运作用,增益分布变得不 均匀,通光口径的中央处增益较大 2)在抽运的不同 时刻增益分布特性也具有很大的差异.3)在相同的 抽运条件下,储能通量和增益由片厚度与掺杂浓度 的乘积 N₀D 决定;当 N₀D 比较小时,N₀D 增加1 倍时储能通量增加1.25 倍,对于7 片长的放大器 链 总的小信号增益将提高45%.当 N₀D 比较大 时,储能通量趋于饱和.

本文的绝大部分工作是在中国科学院上海光学精密机 械研究所高功率激光物理联合实验室完成的,在此表示 感谢.

- [1] H.Zhang, D.Y.Fan, *Physics*, **28**(1999), 79(in Chinese **1**张 华、范滇元 物理, **28**(1999), 79]
- [2] J. H. Alexander, M. Troost, J. E. Welch, The ZAP Laser Analysis Program, System Science and Software Inc., (1971); J. M. McMahon, J. L. Emmett, J. F. Holzrichter et al., *IEEE J. Quantum Elec*tron, QE-9(1973), 992.
- [3] W.F. Hagen, K.S. Jancaitis, H. T. Powell, Laser Program Annual Report, UCRL-50021 (1984), 6.
- [4] J. R. Murray, J. B. Trenholme, J. T. Hunt, Proc. SPIE, 1410 (1991), 28.
- [5] A. C. Erlandson, K. S. Jancaitis, R. W. McCracken, *ICF Quarterly Report* 2(3), UCRL-LR-105821-92-3(1992), 105.
- [6] B. M. V. Wonterghem, J. R. Murray, J. H. Campbell et al., Appl. Opt., 36(1997), 4932.
- [7] A. C. Erlandson, M. D. Rotter, D. N. Frank at al., ICF Quarterly Report 5(1), UCRL-LR-105821-95-1(1995), 18.
- [8] Milton J. Shoup III, J. H. Kelly, D. L. Smith, Appl. Opt., 36 (1997), 5287.

- [9] U. Bafile P. Mazzinghi , Proc. SPIE , 1021(1988), 120.
- [10] H.Zhang, S. X. Xiu, D. Y. Fan, Acta Opt. Sin., 17(1997), 1601(in Chinese)[张 华、徐世祥、范滇元,光学学报,17 (1997),1601].
- [11] J.H. Kelly, D. C. Brown, J. A. Abate *et al.*, *Appl. Opt.*, 20 (1981), 1595.
- [12] H.Zhang, Y.X.Gao, D.Y.Fan, Acta Opt. Sin., 18(1998), 1616(in Chinese)[张 华、高艳霞、范滇元,光学学报,18 (1998),1616].
- [13] H.Zhang, D.Y.Fan, Acta Phys. Sin., 49(2000), 1047 in Chinese)[张 华、范滇元,物理学报, 49(2000), 1047].
- [14] H.T. Powell, A.C. Erlandson, K.S. Jancaitis, Proc. SPIE, 1277 (1990), 103.
- [15] G. Le. Touze, O. Cabourdin, K. S. Jancaitis, Proc. SPIE, 3047 (1997), 571.
- [16] D. M. Pennington, D. Milam, D. Eimerl, Proc. SPIE, 3047 (1997), 630.

ZHANG HUA

(Department of Physics , Nantong Teachers College , Nantong 226007 , China)

FAN DIAN-YUAN

(Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Shanghai 201800, China)
(Received 8 February 2001; revised manuscript received 2 April 2001)

ABSTRACT

Based upon the instantaneous output spectra of a xenon flashlamp, we have constructed a unique dynamic modeling program to predict the gain performance of multi-segment Nd 'glass laser amplifiers. The model, which includes all the dynamic modulations from flashlamp discharging to laser output, may be used in the laser amplifier system optimization. The gain uniformity in the horizontal direction is investigated with the modeling program. The amplified spontaneous emission inside a laser slab first increases the overall decay rate and thereby decreases the stored energy at the slab edges. The stored energy density at the slab center is higher than that at the slab edges when the explosion fraction of the flashlamp becomes large. The influences of the disk thickness and Nd₂O₃ doping level on gain performance are also studied with the modeling program. The stored fluence is determined by the doping – thickness products (Nd ion concentration \times slab thickness) in the multi-segment amplifiers slab , and the details are also given.

Keywords : Nd 'glass laser amplifiers , stored energy density , gain performance PACC : 4260 , 3280B , 3380B , 2588

^{*} Project supported by the Young Science Foundation of the National High Technology Development Program of China (Grant No. 416-98-08) and by the Natural Science Foundation of the Education Commission of Jiangsu Province, China (Grant No. 99KJB140007).